

5. สรุปผลการทดลอง

5.1 ผลการเตรียมสารตัวอย่างโดยใช้เทคนิคเซรามิกส์มาตรฐาน

อุณหภูมิการเผาสำหรับการเตรียมสาร $\text{SnO}_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$, CuO-SrCO_3 และ CoFe_2O_4 โดยวิธีเทคนิคเซรามิกส์มาตรฐานที่ใช้ คือ 1100, 900 และ 1100 °C อัตราการเพิ่มอุณหภูมิของเตา คือ 5 °C/min เวลายืนไฟที่ใช้ คือ 1 ชั่วโมง สารมีลักษณะแข็งและเปราะ $\text{SnO}_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$ มีสีผิวเรียบและสีน้ำตาล CuO-SrCO_3 มีสีผิวเรียบและสีดำ ส่วน CoFe_2O_4 มีผิวเรียบและสีดำ

5.2 ผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ

เมื่อวัดขนาดของสารพบว่าสารมีขนาดลดลงหลังการเผาเนื่องจากความร้อนจากการเผา ทำให้สูญเสียน้ำและความชื้น ส่วนการตรวจสอบเฟสของสารโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ได้ผลดังนี้ สาร 1 : มี 2 เฟส คือ $\text{SnO}_2, \text{Fe}_2\text{O}_3$ โดย SnO_2 มีโครงสร้างอยู่ในระบบเตตระโกนอล และโครงสร้างผลึกเป็นแบบโครงสร้างรูไทล์ ส่วน Fe_2O_3 มีโครงสร้างอยู่ในระบบรอมโบฮีดรอล สาร 2 : มี 2 เฟส คือ CuO และ $\text{Sr}_3\text{Cu}_{1.75}\text{O}_{5.13}$ โดย CuO มีโครงสร้างอยู่ในระบบโมโนคลินิก ส่วน $\text{Sr}_3\text{Cu}_{1.75}\text{O}_{5.13}$ มีโครงสร้างอยู่ในระบบออร์โธโรมบิก สูตร 3 : มี 1 เฟส คือ CoFe_2O_4 โดยสาร CoFe_2O_4 มีโครงสร้างอยู่ในระบบคิวบิก และมีโครงสร้างผลึกแบบสปิเนล (Moulson, 1990)

5.3 ผลการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า

ความต้านทานไฟฟ้าของสารที่ 1 ในช่วงอุณหภูมิ -100 ถึง 800 °C พบว่าสารมีความต้านทานไฟฟ้าลดลงขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น แสดงว่าสารแสดงปรากฏการณ์ NTC (มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานเป็นลบ : α) ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง R และ T ของสารในช่วงที่ 1 มีค่า $\alpha = -6.08 \text{ \%}/^\circ\text{C}$ ($T = -100$ ถึง -85 °C) ค่า α ที่มีค่าติดลบมาก แสดงว่าสารมีความต้านทานไฟฟ้าลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นช่วงที่สารมีความต้านทานไฟฟ้ามากที่สุด

ส่วนความต้านทานไฟฟ้าของสารที่ 2 ในช่วงอุณหภูมิห้อง (24 °C) ถึง 120 °C พบว่าสารมีความต้านทานไฟฟ้าลดลงขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเช่นกัน ค่า $\alpha = -0.91382 \text{ \%}/^\circ\text{C}$ ($T = 24$ ถึง 120 °C)

(Moulson, 1990) สารทั้งสองแสดงพฤติกรรมเป็นเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC สามารถนำไปทำเป็นหัววัดอุณหภูมิ (Soliman, 1993 และ Martinez Sarrion, 1995)

ความต้านทานไฟฟ้าของสารก่อนและหลังการโพลิงที่อุณหภูมิห้องของสารที่ 1 และ 2 พบว่าสารที่มีความต้านทานไฟฟ้าลดลง 10.43 เท่า และ 4.16 เท่า ตามลำดับ ผลของการโพลิงสารนี้เหมือนกันที่พบในสารกลุ่มเพอร์โรอิเล็คทริก เช่น BaTiO_3 และ PbTiO_3 (Buchanan, 1991) เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นอิมพีแดนซ์ ความจุไฟฟ้า และค่าคงที่ไดอิเล็กทริกลดลง ดังนั้นสมบัติของสารขึ้นกับความถี่ (Moulson, 1990 และ Buchanan, 1991) ส่วนความเหนี่ยวนำรวมของหม้อแปลงไฟฟ้าในขณะที่ไม่ใส่แกนและในขณะใส่แกนซึ่งเป็นสาร CoFe_2O_4 พบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิต่ำความเหนี่ยวนำรวมมีค่าเพิ่มขึ้น (Tsuchiya, 1992)

5.4 ผลการประยุกต์ใช้งาน

5.4.1 สาร $\text{SnO}_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$

จากการเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับอุณหภูมิ ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิจริงและอุณหภูมิตัดพบว่าเมื่อพิจารณาความแม่นยำในการวัดของเครื่องวัดอุณหภูมิที่สร้างขึ้นนี้ได้ผลว่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมีค่าประมาณ 3% ดังนั้นสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นหัววัดอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิ 24-200°C นอกจากนี้สารยังสามารถทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของเตาไฟฟ้าได้ในช่วง 24-200°C การทดลองเพื่อนำสารไปประยุกต์ใช้นั้นมีการทำกันน้อยมาก ดังนั้นวิธีการประยุกต์นี้มีประโยชน์มากต่อห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม

5.4.2 สาร $\text{CuO} - \text{SrCO}_3$

การวัดอุณหภูมิของสารให้ความร้อนที่เวลาต่างๆ พบว่าเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่สาร สารจะร้อนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป จากผลการทดลองทำให้สามารถนำไปประยุกต์เป็นสารให้ความร้อน สารให้ความร้อนที่ทำมาจากเซรามิกส์สามารถนำไปใช้แทนลวดโลหะได้ สารให้ความร้อนที่มีผู้ศึกษาและนำไปใช้มีหลายสูตร (Moulson, 1990) และแรงดันเทอร์โมอิเล็กทริกหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าความถี่ที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นแรงดันเทอร์โมอิเล็กทริกมีค่า

เพิ่มขึ้น การวัดปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริกจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบชนิดของพาหะไฟฟ้าในวัสดุได้ (Tanaka, 1997 ; Ravinder, 1994 และ Pujar, 1996)

5.4.3 สาร CoFe_2O_4

สารที่ผ่านการเหนี่ยวนำด้วยสนามแม่เหล็กจากขดลวดมีพฤติกรรมเป็นแท่งแม่เหล็กถาวร และเป็นวัสดุแม่เหล็กแบบอ่อนซึ่งแสดงอำนาจแม่เหล็กเฟอร์ริ (Tsuchiya, 1992) สารสูตรนี้ประยุกต์ทำเป็นอุปกรณ์บันทึกแม่เหล็ก (Akimitsu Morisako, 1996) แต่จากการทดลองพบว่าสารแสดงอำนาจแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ถ้าได้รับสนามแม่เหล็กที่แรงพอและสามารถทำเป็นแท่งแม่เหล็กถาวรแท่งแม่เหล็กที่ทำได้จากสาร CoFe_2O_4 นั้น มีลักษณะเหมือนกันกับที่มีผู้ทดลองในสาร $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ (Pullar, 1997) และ $\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$ (Elwin, 1997)

สนามแม่เหล็กของแท่งสารสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นเองซึ่งอาศัยวงจรเชื่อมต่อกอทพิวดอร์ จากการทดลองพบว่าแท่งสารที่เตรียมได้สามารถให้สนามแม่เหล็กออกมาเป็นปริมาณ 7.082 Wb/m^2 สารสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นหัววัดการหมุน โดยความถี่เชิงมุมมีค่า 312.03 Hz และ ความเร็ว 49.64 rps และหัววัดความถี่ในช่วง $10\text{-}40 \text{ kHz}$ เมื่อพิจารณาความแม่นยำในการวัดของเครื่องวัดความถี่ที่สร้างขึ้นนี้ได้ผลว่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างความถี่จริงกับความถี่ที่วัดได้มีค่าประมาณ 4% ดังนั้นสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นหัววัดความถี่ได้